








	<h2 style="color: red;">IPB019N08N3 G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB019N08N3 G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPB019N08N3 G Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPB019N08N3 G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB019N08N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB019N08N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14200pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB019N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB019N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB019N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB019N08N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB019N08N3 Infineon IPB019N08N3 Infineon</p>	 <p>IPB019N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB019N06L3 G Infineon Technologies IPB019N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB020N04N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7</p>
 <p>IPB019N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB019N06L3 Infineon IPB019N06L3 Infineon</p>	 <p>IPB019N06L3G I I IPB019N06L3G I</p>	 <p>IPB019N08N3G INFINEON IPB019N08N3G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB019N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB019N08N3 G Datenblatt	IPB019N08N3 G-Datenblätter	IPB019N08N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB019N08N3 G
IPB019N08N3 G Electronic	IPB019N08N3 G-Komponenten	IPB019N08N3 G-Verteiler	IPB019N08N3 G-Bild	IPB019N08N3 G-Teil
IPB019N08N3 G Preis	IPB019N08N3 G Hersteller	IPB019N08N3 G Bild	IPB019N08N3 G Aktie	IPB019N08N3 G Inventar
IPB019N08N3 G Neu	IPB019N08N3 G Original	IPB019N08N3 G garantiert	IPB019N08N3 G RFQ	IPB019N08N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited